Table I–4 to Subpart I of Part 98–Default Emission Factors ($1–U_{ij}$) for Gas Utilization Rates (U_{ij}) and By-Product Formation Rates (B_{ijk}) for Semiconductor Manufacturing for 300 mm and 450 mm Wafer Size

Process Type/Sub-Type	Process Gas i											
	CF_4	C_2F_6	CHF_3	CH_2F_2	CH_3F	C_3F_8	C_4F_8	NF_3	SF_6	C_4F_6	C_5F_8	C_4F_8O
	ETCHING/WAFER CLEANING											
$1-U_i$	0.65	0.80	0.42	0.21	0.33	0.30	0.18	0.15	0.32	0.15	0.10	NA
BCF_4	NA	0.21	0.095	0.049	0.045	0.21	0.045	0.046	0.040	0.059	0.11	NA
BC_2F_6	0.079	NA	0.064	0.052	0.00087	0.18	0.031	0.045	0.044	0.074	0.083	NA
BC_4F_6	NA	NA	0.00010	NA	NA	NA	0.018	NA	NA	NA	NA	NA
BC_4F_8	0.00063	NA	0.00080	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00012	NA
$BCHF_3$	0.011	NA	NA	0.050	0.0057	0.012	0.027	0.025	0.0037	0.019	0.0069	NA
BCH_2F_2	NA	NA	0.0036	NA	0.0023	NA	0.0015	0.00086	0.000029	0.000030	NA	NA
BCH_3F	0.0080	NA	0.0080	0.0080	NA	0.00073	NA	0.0080	NA	NA	NA	NA
	CHAMBER CLEANING											
	In situ plasma cleaning											
$1-U_i$	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.23	NA	NA	NA	NA
BCF_4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.037	NA	NA	NA	NA
BC_2F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BC_3F_8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Remote plasma cleaning											
$1-U_i$	NA	NA	NA	NA	NA	0.063	NA	0.018	NA	NA	NA	NA
BCF_4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.075	NA	NA	NA	NA
BC_2F_6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA